



光モジュール及び光伝送装置の低コスト化に向け、他の端面入射型光デバイスとの整合性が良く、容易に高精度に位置決めを行うことのできる半導体受光素子を提供することを目的として、光吸收層19が形成されている端面入射型受光素子において、該受光素子の検出光を吸収してしまった光吸收層19の一部を除外した空間領域を形成することで、該受光素子の主平面を貫通、透過する検出光の透過量が30%以上である主平面に平行なマーカ検出用領域24を少なくとも $100 \mu m^2$ 備えることにより、光デバイス26上のマーカ23の検出を容易にし、該受光素子の位置決めを高精度に行うようにした。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AL アルバニア	FI フィンランド	LK スリ・ランカ	SI スロヴェニア
AM アルメニア	FR フランス	LR リベリア	SK スロヴァキア
AT オーストリア	GA ガボン	LS レソト	SL シエラ・レオネ
AU オーストラリア	GB 英国	LT リトアニア	SN セネガル
AZ アゼルバイジャン	GD グレナダ	LU ルクセンブルグ	SZ スワジランド
BA ボスニア・ヘルツェゴビナ	GE グルジア	LV ラトヴィア	TD チャード
BB バルバドス	GH ガーナ	MC モナコ	TG トーゴー
BE ベルギー	GM ガンビア	MD モルドバ	TJ タジキスタン
BF ブルキナ・ファソ	GN ギニア	MG マダガスカル	TM トルクメニスタン
BG ブルガリア	GW ギニア・ビサオ	MK マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TR トルコ
BJ ベナン	GR ギリシャ	共和国	TT トリニダッド・トバゴ
BR ブラジル	HR クロアチア	ML マリ	UA ウクライナ
BY ベラルーシ	HU ハンガリー	MN モンゴル	UG ウガンダ
CA カナダ	ID インドネシア	MR モーリタニア	US 米国
CF 中央アフリカ	IE アイルランド	MW マラウイ	UZ ウズベキスタン
CG コンゴー	IL イスラエル	MX メキシコ	VN ヴィエトナム
CH スイス	IN インド	NE ニジェール	YU ユーゴースラビア
CI コートジボアール	IS アイスランド	NL オランダ	ZW ジンバブエ
CM カメルーン	IT イタリア	NO ノールウェー	
CN 中国	JP 日本	NZ ニュージーランド	
CU キューバ	KE ケニア	PL ポーランド	
CY キプロス	KG キルギスタン	PT ポルトガル	
CZ チェコ	KP 北朝鮮	RO ルーマニア	
DE ドイツ	KR 韓国	RU ロシア	
DK デンマーク	KZ カザフスタン	SD スーダン	
EE エストニア	LC セントルシア	SE スウェーデン	
ES スペイン	LI リヒテンシュタイン	SG シンガポール	

## 明細書

## 半導体受光素子および光伝送装置

## 技術分野

本発明は、光通信分野等に用いられる半導体受光素子および光伝送装置に関するものである。

## 背景技術

近年、情報サービス網の拡充のため、光通信分野においても低コスト化が望まれている。低価格な光通信システムを構築するためには、光信号を電気信号に、電気信号を光信号に変換する光モジュールの低コスト化が鍵である。これには、同一基板上に平易な実装方式で集積化できる光デバイスが必要である。

半導体レーザダイオード、光変調器や光スイッチ等に代表される光デバイスは一般に端面入射型の構造を有し、光を基板面に平行な方向に入射するものである。一方、半導体受光素子は一般に基板面内に垂直な方向から光信号を受光する面受光型である。したがって、面受光型の半導体受光素子は他の光デバイスと光信号の入出射方向が異なるため、集積化の観点から整合性が良くない。

一方、他の光デバイスと整合性が良い例えば日本特開昭64-90570号に記載されているような端面入射型の半導体受光素子が従来より知られている。ところが、端面入射型の半導体受光素子はその構造から光デバイスからの光の出射位置と半導体受光素子の受光面との位置関係が、受光素子の感度に大きく依存する。そのため、パッシブ型のアライメントでは、光デバイス上での端面入射型半導体受光素子の位置を高精度に計測する手段が必要とされている。

上記従来技術では、端面入射型受光素子を光デバイスに実装する際、受光素子の光デバイス側と光デバイス部分にマーカを作成し、両者を透過することのできる光、例えば1.3 μm付近の波長の光により、それぞれのマーカ位置を検出することで、光デバイス上での端面入射型の受光素子の位置決めを行っていた。

しかし、光通信等で多用される1.3～1.6 μm程度の光を受光する受光素子では、1.3 μm付近の波長の透過光が受光層で吸収され、位置決めの目標となるマーカの位置を検出することが困難であった。

本発明の目的は、任意の波長の吸収層を持つ半導体受光素子を光デバイスに実装する際の位置決めを容易にする半導体受光素子およびその製造方法を提供することにある。

また、本発明の他の目的は、上記本発明による半導体受光素子を受信素子として、または半導体レーザ光のモニタ素子として実装した、低コストの光モジュールあるいは光伝送装置を提供することにある。

15

### 発明の開示

上記目的を達成するため本発明は、ある部材の特定個所に搭載されるべき、光吸収層を備える光学素子において、当該光学素子を前記特定個所に位置決めする際には、前記光吸収層により波長範囲の少なくとも一部が吸収される光を当該光学素子へ照射し、その透過光を検出することで位置決めするものであって、当該光学素子が搭載されるべき面に略平行な面に投影された当該光学素子の2次元投影領域の中に、前記光吸収層を含まず、前記照射光の透過率が残りの領域よりも高く、その位置が識別可能である領域を備える。

25 また、上記目的を達成するため本発明は、他の光デバイスを備える基板上に搭載される、光吸収層を有する受光素子において、前記基板および当該半導体受光素子のうち少なくとも前記基板に設けられた位置決め

用マーカとして機能する部分に対向する個所の光吸收層を除外した。

より具体的には、例えば図1に示すような、上部第2コア層18と下部第2コア層20及び上部クラッド層17と下部クラッド層21で挟まれた光吸收層19を持つ端面入射型半導体受光素子において、当該端面入射型受光素子が実装される光デバイス上の位置決め用のマーカ23を計測するためのマーカ検出用空間領域（位置決め用領域）24が設けられた端面入射型半導体受光素子を提供する。ここで、図1の信号光11と光吸收層19の接している個所が当該端面入射型半導体受光素子の受光領域である。

上記本発明の端面入射型受光素子は、例えば図4に示すように、光吸收層19を形成する際にマスク等により結晶層の成長個所を選択し、受光領域の光吸收層19は残し、光デバイス上の位置決め用マーカ23に対向する個所の光吸收層19が除外される（形成されない）ようにして、マーカ23を検出するための空間領域24を形成する。マーカ検出用空間領域24を透過して位置決め用マーカ23を検出するために照射される照明光（以下では検出光と呼ぶ）の光透過率は、例えば端面入射型受光素子に照射される検出光の30%を越える構造とする。

上記本発明の端面入射型受光素子によれば、下方から照射される位置決め用の検出光の光吸收層19による減衰が、光吸收層19を残した場合に比べ極めて少ないため、端面入射型受光素子の影になる光デバイス上のマーカ23を端面入射型受光素子を透過して観察することが容易となり、生産効率が向上する。

また、上記本発明の端面入射型受光素子によれば、光モジュール基板26上の実装精度も向上するため、受光効率も向上する。このため、上記本発明の端面入射型受光素子を、図7および図8に示すような光ファイバ38を固定するためのV溝を有する基板37上に受信素子もしくは半導体レーザ41のモニタ素子として、本発明の端面入射型受光素子3

1 を光学レンズなしで集積化する構成としてもよい。

また、図 9 に示すように信号光入射用の光ファイバ 5 2 の付いた V 溝基板 5 4 上に受信用の本発明の端面入射型受光素子 5 5 をパッシブアライメント法を用いて集積化し、さらにプリアンプ I C 5 6 を実装したり、  
5 さらに、これをセラミックあるいは樹脂できたベース 5 3 とキャップ 5 1 にてパッケージングする構成としてもよい。ベース 5 3 とキャップ 5 1 の代わりに樹脂にてトランスマウルドを用いても良い。

また、本発明の端面入射型受光素子を半導体レーザのモニタ用として用いた光送信モジュールあるいは同一基板上に本発明の端面入射型受光  
10 素子を受信用、半導体レーザモニタ用としてそれぞれ搭載した光送受信モジュールを用いても良い。

さらに、図 10 に示すように本発明の端面入射型受光素子を搭載した光ファイバ 6 3 付き光モジュール 6 4 と、受信 I C 6 1 等の電子回路を同一ボード 6 2 上に搭載し、これを送信あるいは受信あるいは送受信装置として光伝送システムに用いてもよい。

また、上記目的を達成するために本発明は、基板上に光吸收層を含む複数の異なる薄膜層を順次積層して形成される、端面入射型の半導体受光素子の製造方法において、前記光吸收層以降の薄膜層を積層する工程では、当該半導体受光素子が位置決めされるべき個所に対応するよう  
20 予め決められた領域での薄膜成長を禁止するか、あるいは、当該半導体受光素子が位置決めされるべき個所に対応するように予め決められた領域下に存在する前記光吸收層を取り除くためのエッチング工程を含む。

#### 図面の簡単な説明

25 第 1 図は、本発明の実施形態 1 による端面入射型受光素子の断面図である。第 2 図は、本発明の実施形態 1 による端面入射型受光素子の輝度分布図である。第 3 図は、本発明の実施形態 1 による端面入射型受光素

子の輝度分布図である。第4図は、本発明の実施形態1による端面入射型受光素子の断面図である。第5図は、本発明の実施形態1による端面入射型受光素子の断面図である。第6図は、本発明の実施形態1による端面入射型受光素子の断面図である。第7図は、本発明の実施形態2の全体構造を示す斜視図である。第8図は、本発明の実施形態3の全体構造を示す斜視図である。第9図は、本発明の実施形態4の全体構造を示す斜視図である。第10図は、本発明の実施形態5の全体構造を示す斜視図である。第11図は、本発明の実施形態1による端面入射型受光素子の断面図である。

10

### 発明を実施するための最良の形態

以下に本発明による受光素子および該受光素子を備える装置の実施形態を、図を参照して説明する。

#### [実施形態1]

15 I n G a A l A s 系化合物半導体を用いた本発明の一実施形態の断面構造を図1に示す。

本実施形態による半導体受光素子は、分子線エピタキシ(MBE)法によりp-InP基板16に、n-InAlAs上部クラッド層17を1.0μm、n-InGaAlAs上部第2コア層18を1.5μm、20アンドープInGaAlAs光吸收層19を1.5μm、p-InGaAlAs下部第2コア層20を1.5μm、p-InAlAs下部クラッド層21を0.5μm、n-InGaAsコンタクト層15'を0.2μmを順次積層することでその基本構造が形成される。

さらに、本実施形態による半導体受光素子は、n-InGaAsコンタクト層15'に隣接して設けられたp型電極22と、当該半導体素子が搭載されるべき光デバイス26との接続用はんだ層25と、p-InP基板16の本図上方に積層されるコンタクト層15、SiN絶縁膜1

4 および n 型電極 1 3 とを備えている。

ここで、アンドープ InGaAlAs 光吸收層 1 9 は、例えば、位置決めの際に図 1 の下方から照射され、p-InP 基板 1 6 を透過し、半導体受光素子の下側に作られたマーカを検出するための、1. 3  $\mu$ m 付近の波長を備える検出光を吸収してしまう。

そのため、本実施形態においては、当該半導体受光素子を実装する光モジュール基板 2 6 側のマーカ 2 3 の検出を可能とするために、アンドープ InGaAlAs 光吸收層 1 9 、 p-InGaAlAs 下部第 2 コア層 2 0 、 p-InAlAs 下部クラッド層 2 1 の形成の際にマスク等を使い、基板側のマーカ 2 3 を検出できるようにアンドープ InGaAlAs 光吸收層 1 9 が除外された空間領域（位置決め用領域） 2 4 が形成されるように結晶成長を行う。なお、上記の構造は、半導体受光素子に上記各層を積層後にエッチング等により取り除いても、同様な構造を形成することができる。

すなわち、本発明において特徴的な構造である、位置決め用マーカの検出を可能するためにアンドープ InGaAlAs 光吸收層 1 9 が除外された空間領域（以下ではマーカ検出領域と呼ぶ）を形成するために、新たな工程を追加する必要は全くなく、従来から実施されていた工程において、当該マーカ検出領域を形成するようにマスクの形状を変える等の少々の修正を加えるだけで良い。

マーカ検出領域 2 4 の大きさは、必要とされる搭載精度及びマーカ 2 3 の検出に用いる撮像装置の分解能に応じて決定する。例えば、信号光 1 1 に対する半導体受光素子の必要な搭載精度が  $\pm 1 \mu$ m とすると、計測精度は少なくとも  $\pm 0.1 \mu$ m 必要となる。その精度を確保するマーカ検出領域 2 4 は、分解能  $1 \mu$ m のカメラによりマーカ 2 3 の境界面もしくは重心点の計測を行って所定の精度を出すためには、1 辺  $10 \mu$ m 以上 ( $100 \mu$ m<sup>2</sup>) の領域が必要となる。

また、半導体受光素子に検出光を透過しないメタライズ層 13、25 がある場合、マーカ検出領域 24 を上方から観察して影にならない部分を  $100 \mu m^2$  以上確保することが必要となる。

マーカ 23 は、位置決めの際に照射される検出光の非透過部と透過部 5 のエッジを透過する光量の差によって計測するが、該透過部が入射した光を全て透過するわけではなく一部を減衰する。ここで、入射した光の全て透過する時のコントラストの値を 100% とすると、30% のコントラストがある場合の輝度分布は図 2 に示すようになる。

ところで、検出光によって得られる光学像の明暗部のエッジを特定するためには、エッジ付近の輝度分布の傾き（コントラストに依存する） 10 と輝度上の雑音とを考慮する必要がある。例えば、本発明が適用される技術分野の位置決めにおいて良く使用されている、近赤外線付近を計測するカメラでは、映像信号に生じる雑音は 5% 程度生じている。このため、目標とする計測精度以内に輝度分布がそれ以上の傾きを持たなければ、要求される精度を満たすことはできない。 15

コントラストを 20% から 100% まで変化させた場合の輝度分布を横軸に位置、縦軸に輝度をとったグラフにプロットすると、図 3 に示すようになる。これらの輝度分布から、位置決めに必要となる計測精度を  $\pm 0.1 \mu m$  とすると、本実施形態において必要なコントラストは 30% 以上となる。 20

図 1 のマーカ検出領域 24 を含み、信号光 11 に対して垂直な断面構造の一例を図 4 に示す。本例では、当該半導体受光素子の端面から入射する信号光 11（図 1 参照）の光軸に対して、左右の位置に 2 個所のマーカ検出領域 24 を形成している。これはマーカ検出領域 24 が 1 個所のみの場合、半導体受光素子の水平面内の角度検出が難しくなるためである。本例に示すように、半導体受光素子内に 2 個以上のマーカ検出領域 24 を形成することで、水平面内の角度検出を容易とすることがで 25

きる。

本実施形態を利用した半導体受光素子の他の構造例を図5に示す。図5は入射する信号光に対して垂直に切断した断面図である。

本例では、受光領域27との精度W<sub>a</sub>、W<sub>b</sub>を相対的に確保しつつ、

5 吸収層19を削除した空間領域それ自体を、当該半導体受光素子側の位置決め用マーカとして利用したものである。通常W<sub>a</sub>、W<sub>b</sub>は同じ長さに設定する。2つの長さW<sub>a</sub>、W<sub>b</sub>を用いる理由は、マーカを1個所だけ設け、該マーカからの距離だけに基づいて位置決めを実施しようとする場合におこり得る、計測の際の光学収差や露光時の光の回り込みの差10 によるマーカ自体の大きさの膨らみ等の誤差を吸収するためである。

本例により相対的精度W<sub>a</sub>、W<sub>b</sub>を利用して2個所のマーカ検出領域24を形成し、光吸収層19とマーカ検出領域24の境界領域を検出することにより、半導体受光素子の位置を高精度に測定することが可能となる。

15 また、図6に示すように、位置決めをした場合に、図5に示した相対的精度を確保したマーカ検出領域24内にそれぞれ位置するように、光モジュール基板26のマーカ23を作成してもよい。本例のような構成によれば、マーカ検出領域24とマーカ23の両者を同時に、高精度に観察することが可能となり、高い位置精度で搭載することができる。

20 また、図11に示すように、半導体受光素子に形成された一対のマーカ検出領域24内のそれぞれに受光素子側マーカ28を設け、各受光素子側マーカ28とそれに対応する基板側マーカ23とが予め定めた相対位置関係を満足するように、位置決めする構成としてもよい。

## [実施形態2]

25 本発明の端面入射型受光素子を用いた光モジュールの一実施形態の構造を図7に示す。

本実施形態では、絶縁膜34、および電気配線32を有するV溝基板

3 7 上に、本発明の端面入射型受光素子 3 1 をパッシブアライメント法を用いてフリップチップ実装している。ここで端面入射型受光素子 3 1 には片面に n 型、反対側に p 型電極を有するものを用い、端面入射型受光素子 3 1 と電気配線 3 2 との接続には AuSn 半田を使用した。

5 本実施形態においては、さらに、端面入射型受光素子 3 1 の受光面の左右 2 個所に光吸収層 1 9 を排除して形成したマーカ検出用領域 2 4 を設けると共に、端面入射型受光素子 3 1 が位置決めされた場合に、これらマーカ検出用領域 2 4 の各々の領域内に位置するように、V 溝基板 3 7 のマーカ 2 3 を一対設けている。

10 これらの構成により、端面入射型受光素子 3 1 および V 溝基板 3 7 の位置を高精度に計測できるとともに、両者の位置決めを高精度に実現できる構造としている。

本実施形態によれば、両者の検出精度は  $\pm 0.1 \mu m$  以内となり、実装精度は  $\pm 1.0 \mu m$  以内に抑えられた。また、 $1.3 \mu m$  光に対する 15 半導体受光素子 3 1 の受光感度は  $0.85 A/W$  と高い値が得られた。

### [実施形態 3]

本発明の端面入射型受光素子を用いた光モジュールの他の実施形態の構造を図 8 に示す。

本実施形態では、絶縁膜 3 4 、モニタ受光素子用電気配線 3 2 、および半導体レーザ用電気配線 4 2 を有する V 溝基板 3 7 上に、半導体レーザ 4 1 と本発明の端面入射型受光素子 3 1 をパッシブアライメント法を用いて、フリップチップ実装している。ここで、端面入射型受光素子 3 1 には、片面に n 型、反対側に p 型電極を有するものを用い、端面入射型受光素子 3 1 と電気配線 3 2 の接続には AuSn 半田を使用した。

25 本実施形態においては、さらに、端面入射型受光素子 3 1 の受光面の左右 2 個所に光吸収層 1 9 を排除して形成したマーカ検出用領域 2 4 を設けると共に、端面入射型受光素子 3 1 が位置決めされた場合に、これ

らマーカ検出用領域 24 の各々の領域内に位置するように、V溝基板 37 のマーカ 23 を一対設けている。

これらの構成により、端面入射型受光素子 31 および V溝基板 37 の位置を高精度に計測できるとともに、両者の位置決めを高精度に実現できる構造としている。その後フラットエンドの光ファイバ 38 を V溝に固定した。

本実施形態によれば、各素子の搭載時及び光ファイバ固定時の位置ずれは  $\pm 1 \mu m$  以内に抑えられ、半導体レーザ 41 とモニタ用端面入射型受光素子 31 間の光結合損失は  $2 \sim 3 \text{ dB}$  であった。また外部出力  $1 \text{ mW}$  時のモニタ電流は  $400 \mu \text{A}$  と良好な値が得られた。

#### [実施形態 4]

本発明の端面入射型受光素子を用い、パッケージングされた光受信モジュールの一実施形態の構造を図 9 に示す。

本実施形態では、V溝基板 54 上に受信用の本発明による端面入射型受光素子 55 をパッシブアライメント法を用いて実装している。さらに高感度化のために受信用プリアンプ I C 56 も V溝基板 54 上に実装した。その後、信号光入射用の光ファイバ 52 を付け、セラミック製のベース 53 に固定し、キャップ 51 にて蓋をした。

作製した本実施形態による光モジュールを伝送評価したところ、信号光波長  $1.3 \mu m$  、伝送速度  $50 \text{ Mb/s}$  のバースト伝送において、 $10 \text{ の} -8$  乗の誤り率における最小受光感度は  $-38 \text{ dBm}$  と良好であった。

なお、セラミック製のベース 53 およびキャップ 51 の代わりに樹脂製のもの、あるいは樹脂のトランスマルチモードを用いても良い。また、本発明の端面入射型受光素子を用いた送信および送受信光モジュールをパッケージングしても良い。

#### [実施形態 5]

本発明の端面入射型受光素子を用いた光伝送装置の一実施形態を図 10 に示す。

本実施形態では、本発明の端面入射型受光素子が搭載され、信号光入射用の光ファイバ 6 3 が付いた光受信モジュール 6 4 と、受信 I C 6 1 およびその他の電子部品をボード 6 2 上に搭載している。  
5

作製した本実施形態による光伝送装置の伝送評価を行った。信号光波長  $1.3 \mu m$ 、伝送速度  $50 Mb/s$  のバースト伝送において、 $10 \times 8$  乗の誤り率における最小受光感度は  $-38 dBm$  と良好であった。

なお、上記光受信モジュールの代わりに、本発明の端面入射型受光素子が集積化された光送信モジュールおよび光送受信モジュールを搭載しても良い。  
10

### 産業上の利用可能性

本発明によれば、端面入射型半導体受光素子を光デバイスに高精度で位置決めする事が可能となり、光学レンズを用いることなく容易に高光結合をとることができる。したがって、本発明の端面入射型半導体受光素子を利用することにより、煩雑な実装工程をとらずに低コストな光モジュールおよび光伝送装置を作製することが可能となる。  
15

## 請求の範囲

1. 基板に搭載されるべき面に略平行な面に光吸收層を備えた半導体受光素子であって、該半導体受光素子が前記搭載されるべき面の方向に投影された場合に得られる該半導体受光素子の2次元投影領域の中に、前記光吸收層の光透過率と異なる光透過率の領域を透過した光が投影されるように構成したことを特徴とする半導体受光素子。  
5
2. 基板に搭載されるべき面に略平行な面に光吸收層を備えた半導体受光素子であって、該該光吸收層の一部に光吸收層の光透過率よりも高い光透過率の領域を形成したことを特徴とする半導体受光素子。
- 10 3. 前記光吸收層よりも高い光透過率の領域の該光透過率が、前記半導体受光素子を前記基板に搭載するときに照明する照明光に対して、30%以上であることを特徴とする請求項2記載の半導体受光素子。
4. 前記光透過率が30%以上である領域が前記半導体受光素子を前記基板に搭載するときに前記基板上に投影される投影領域の広さが、少なくとも $100 \mu m^2$ であることを特徴とする請求項3記載の半導体受光素子。  
15
5. 前記光透過率が30%以上である領域が、少なくとも2個所以上あることを特徴とする請求項3記載の半導体受光素子。
6. 当該半導体受光素子は、端面入射型受光素子であって、  
20 前記光透過率が30%以上である領域が少なくとも1対以上存在するもので、各対の前記領域はそれぞれ、当該端面入射型半導体受光素子の受光面の光軸の左右に対応して位置するように配置されていることを特徴とする請求項3記載の半導体受光素子。
7. 基板に搭載されるべき面に略平行な面に光吸收層を備えた半導体受光素子であって、該半導体受光素子が前記搭載されるべき面の方向に投影された場合に得られる該半導体受光素子の2次元投影領域の中に、前記光吸收層の光透過率と異なる光透過率の領域を透過した光が投影され  
25

るとともに、該光吸收層の光透過率と異なる光透過率の領域を透過した光が投影される領域の中に前記半導体素子に掲載した位置決め用マーカの像が投影されるように構成したことを特徴とする半導体受光素子。

8. 前記光吸收層の光透過率と異なる光透過率の領域が、前記光吸收層を除外した領域であることを特徴とする請求項2または7の何れかに記載の半導体受光素子。

9. 前記光吸收層の光透過率と異なる光透過率の領域内に、前記位置決め用マーカを備えることを特徴とする請求項2または7の何れかに記載の半導体受光素子。

10 10. 請求項1乃至9のいずれかに記載の半導体受光素子を光ファイバと光結合して同一基板上に実装したことを特徴とする光モジュール。

11. 半導体レーザと光ファイバと、それらのうち少なくとも一方と光結合される請求項1乃至9のいずれかに記載の半導体受光素子とを、同一基板上に実装したことを特徴とする光モジュール。

15 12. 前記基板上に実装した半導体受光素子が、セラミックまたは樹脂のいずれか一方によりパッケージングして構成されることを特徴とする請求項10または11のいずれかに記載の光モジュール。

13. 前記基板上には電子回路がさらに搭載され、該電子回路が、セラミックまたは樹脂のいずれか一方によりパッケージングして構成されることを特徴とする請求項10又は11の何れかに記載の光モジュール。

20 14. 請求項10乃至13のいずれかに記載の光モジュールと、当該光モジュールと接続して光信号の送信処理および受信処理のうち少なくとも一方の処理を実行する電子回路とを同一ボード上に搭載したことを特徴とする光伝送装置。

25 15. 基板上に光吸收層を含む複数の異なる薄膜層を順次積層して形成される、端面入射型の半導体受光素子の製造方法において、

前記光吸收層以降の薄膜層を積層する工程では、当該半導体受光素子

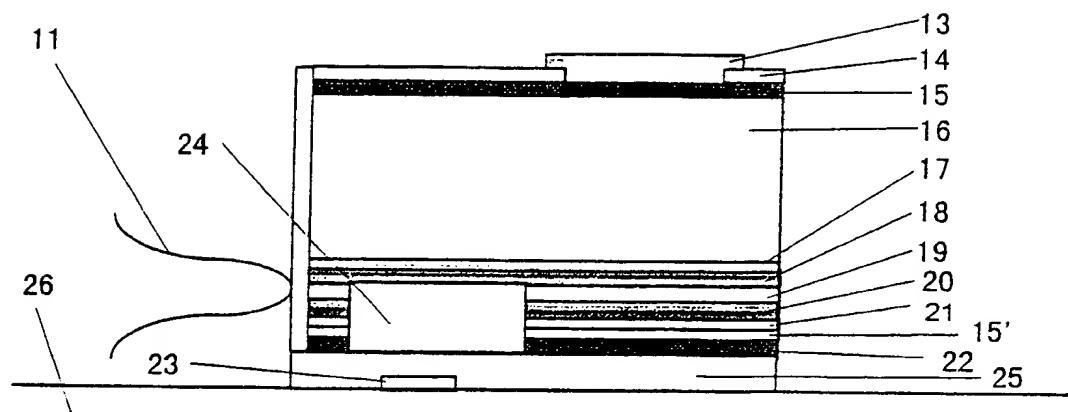
が位置決めされるべき個所に対応するように予め決められた領域での薄膜成長が禁止されること

を特徴とする半導体受光素子の製造方法。

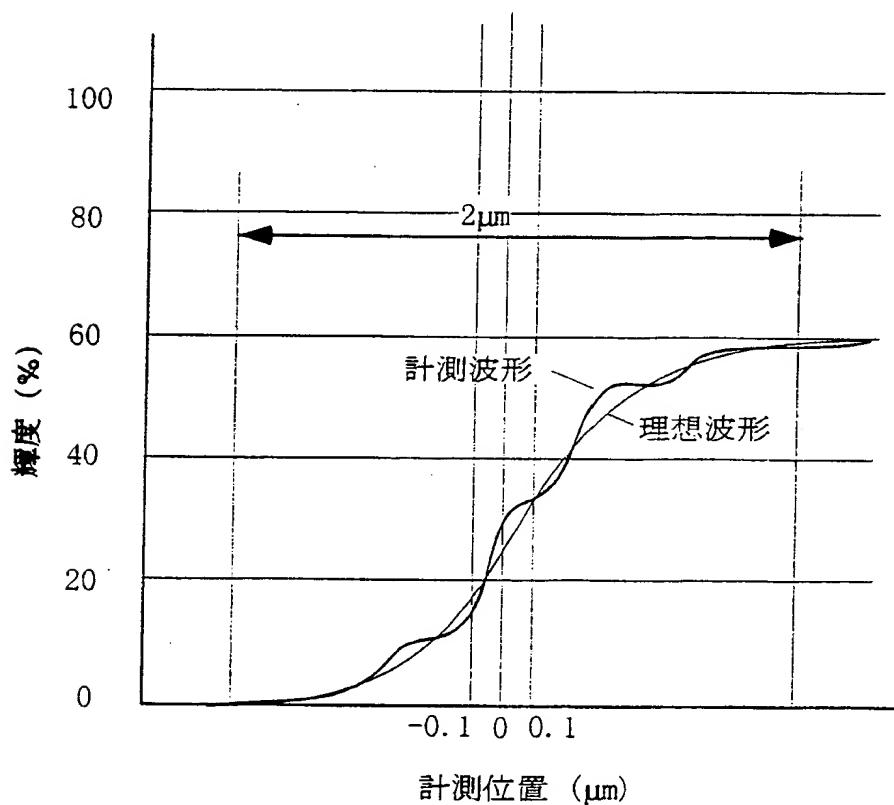
16. 基板上に光吸収層を含む複数の異なる薄膜層を順次積層して形成  
5 される、端面入射型の半導体受光素子の製造方法において、

当該半導体受光素子が位置決めされるべき個所に対応するように予め  
決められた領域下に存在する前記光吸収層を取り除くためのエッチング  
工程を含むことを特徴とする半導体受光素子の製造方法。

第1図

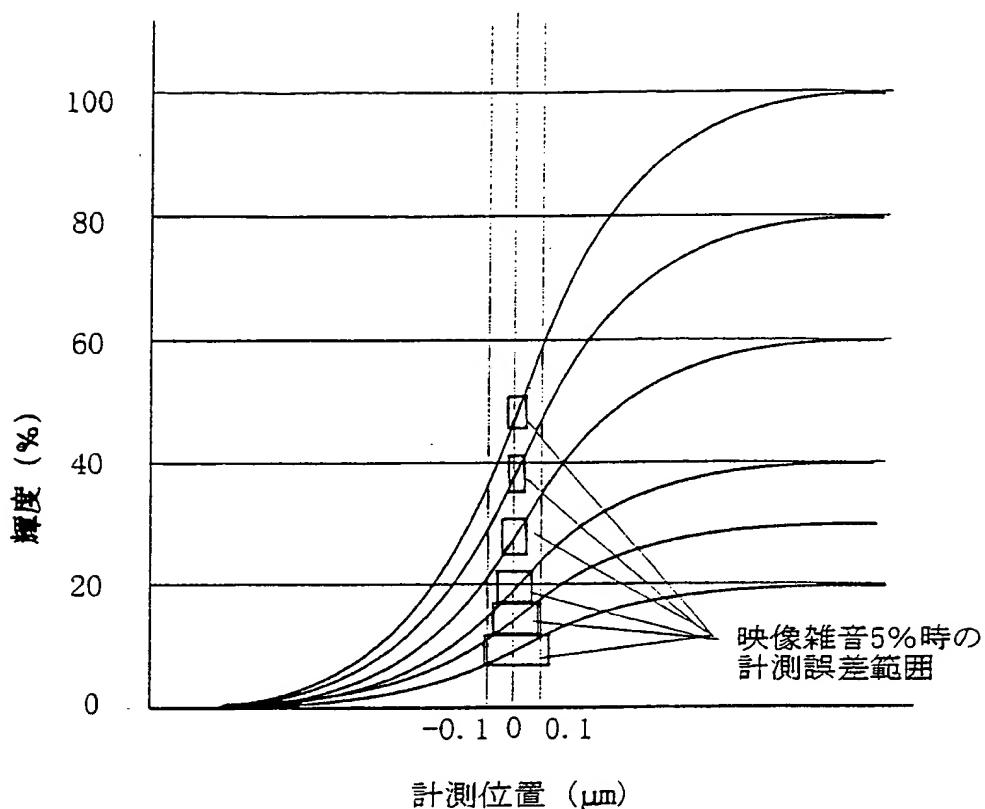


第2図

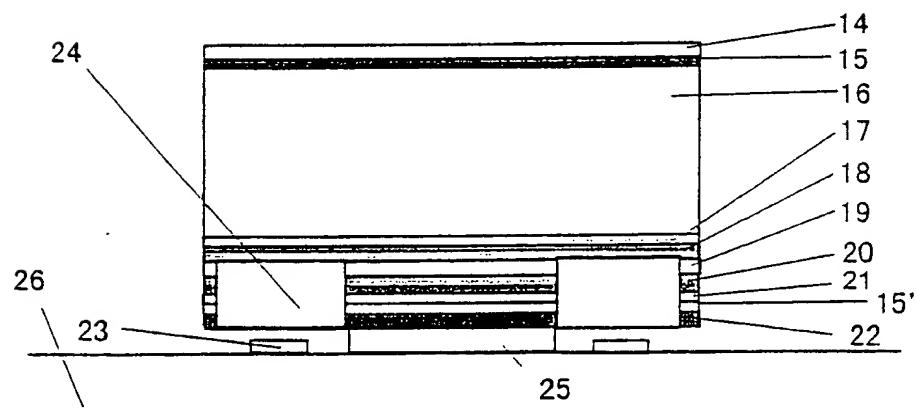


**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

第3図

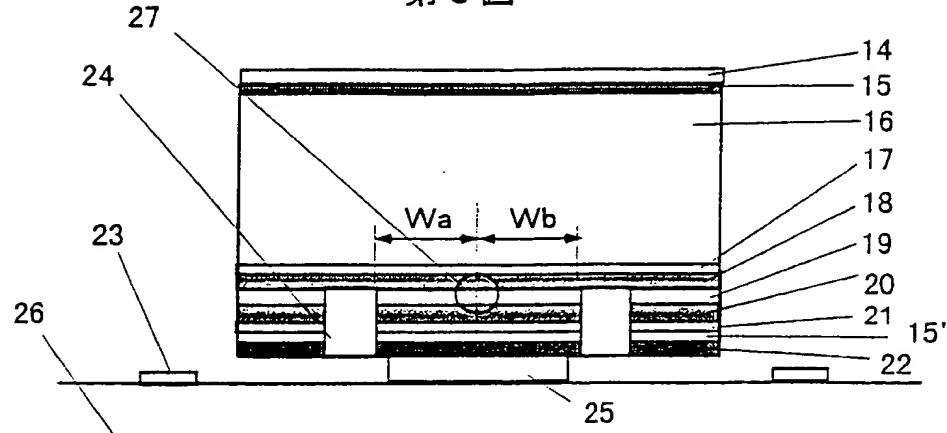


第4図

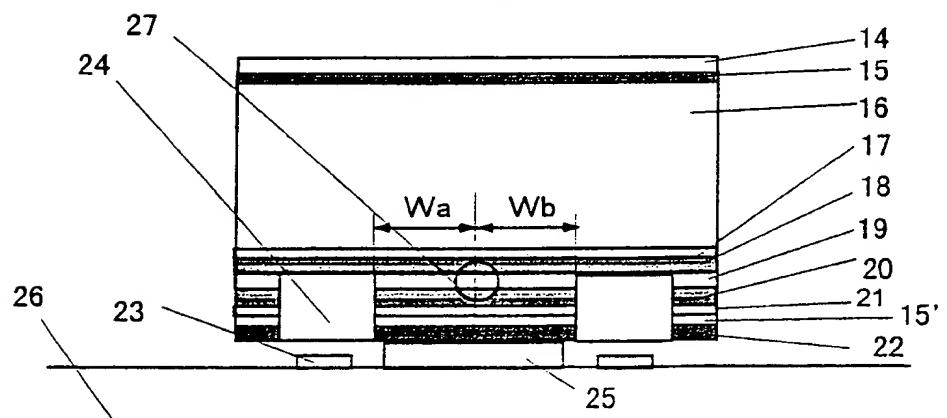


**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

第5図

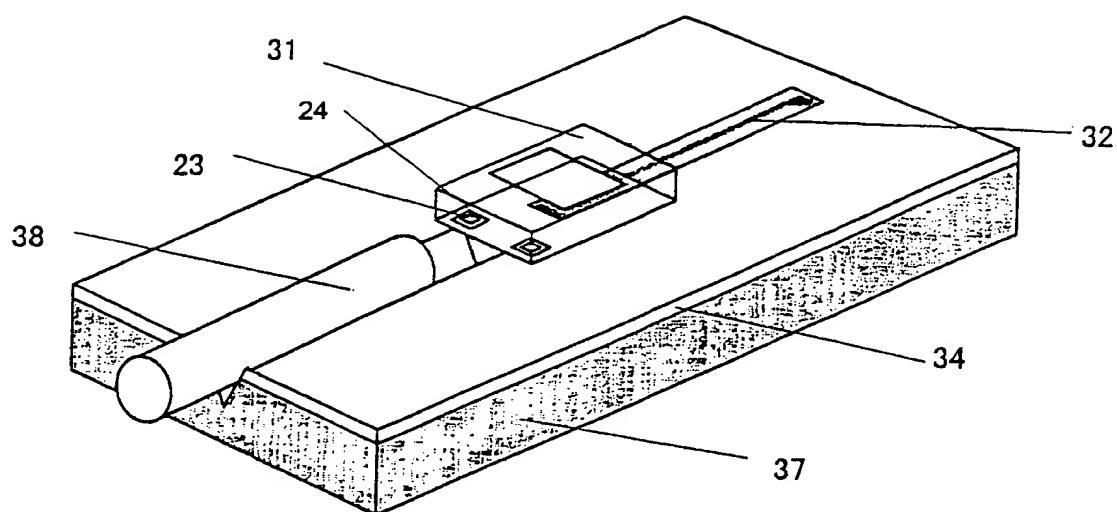


第6図

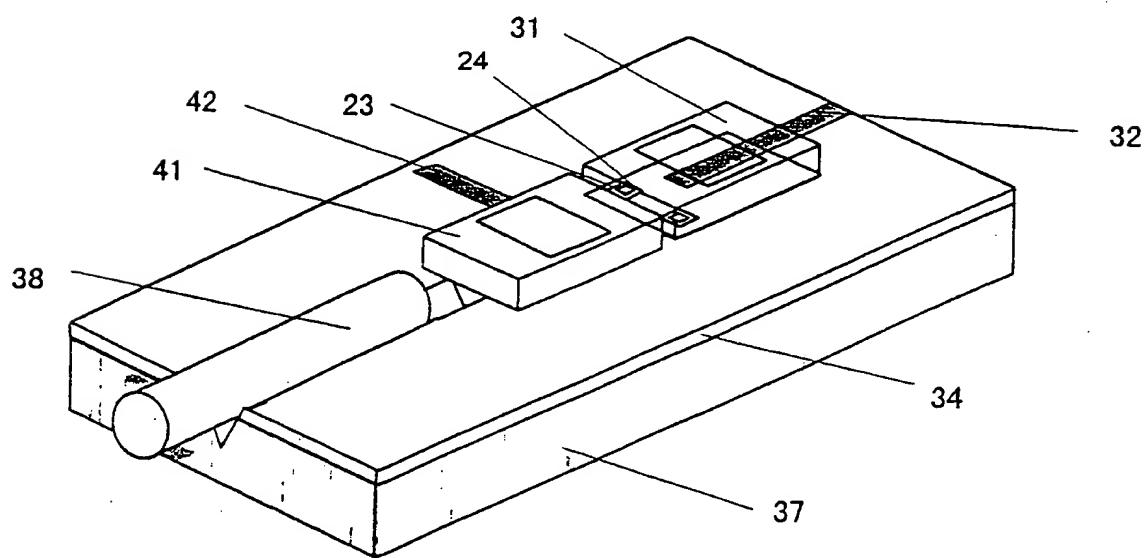


**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

第7図

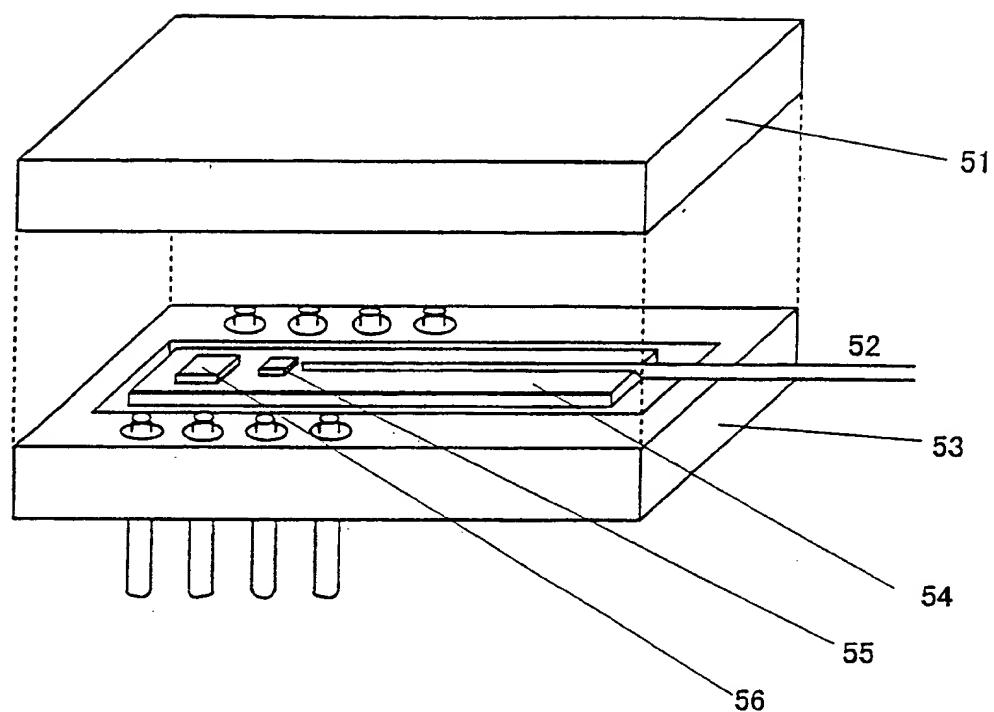


第8図

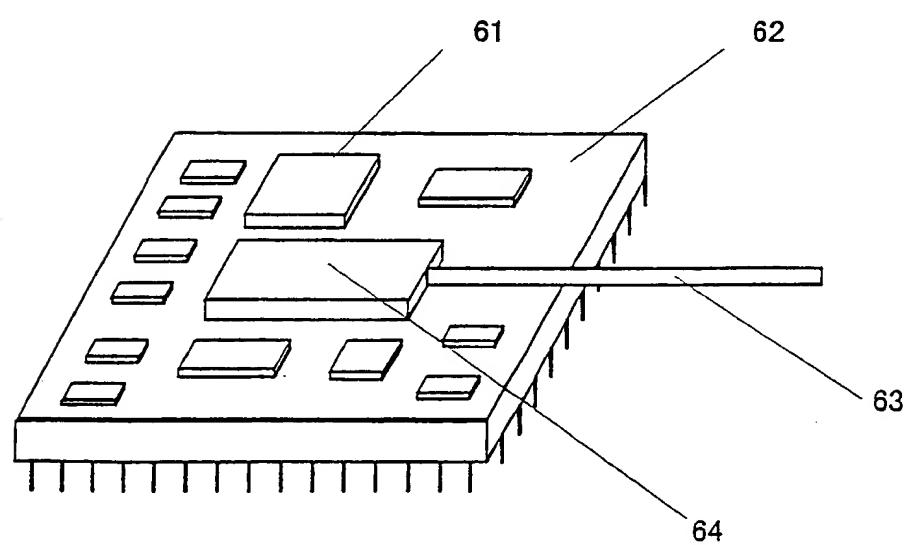


**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

第9図

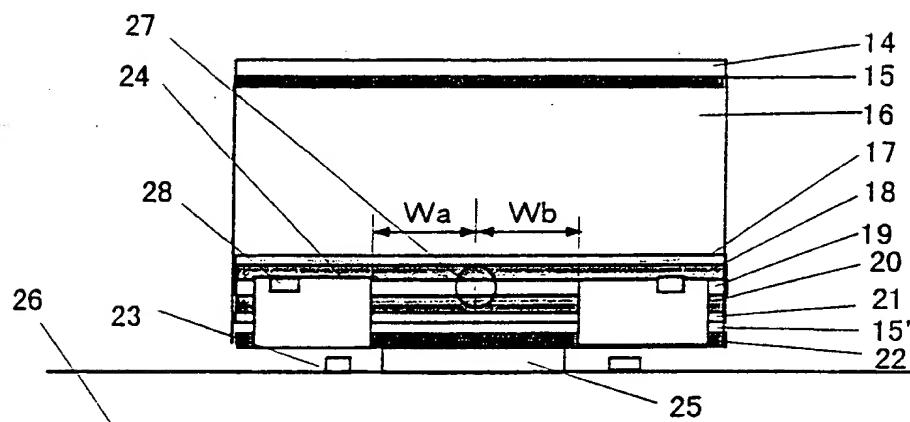


第10図



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

第 11 図



THIS PAGE BLANK (USPTO)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP98/03791

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
Int.Cl<sup>6</sup> H01L31/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
Int.Cl<sup>6</sup> H01L31/02, 31/12

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
Jitsuyo Shinan Koho 1940-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1998  
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1998

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y ✓	JP, 02-094573, A (Nippon Telegraph & Telephone Corp.), 5 April, 1990 (05. 04. 90), Figs. 1, 5 ; page 3, lower right column, 3rd line from the bottom to page 4, upper left column, line 6 (Family: none)	1-6, 8, 15, 16 7, 9-14
X Y ✓	JP, 05-183185, A (Fujitsu Ltd.), 23 July, 1993 (23. 07. 93), Figs. 1, 18 ; Par. Nos. [0006] to [0008], [0031] to [0035] (Family: none)	1-6, 10-11 7-9, 12-14
Y ✓	JP, 09-152527, A (Hitachi, Ltd.), 10 June, 1997 (10. 06. 97), Fig. 2 ; Par. No. [0042] (Family: none)	7-14
Y ✓	JP, 09-191131, A (Hitachi, Ltd.), 22 July, 1997 (22. 07. 97), Fig. 1 ; Par. Nos. [0002], [0003], [0006], [0007] (Family: none)	7-14

Further documents are listed in the continuation of Box C.  See patent family annex.

"*	Special categories of cited documents:	
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E"	earlier document but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&" document member of the same patent family
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 19 November, 1998 (19. 11. 98)	Date of mailing of the international search report 1 December, 1998 (01. 12. 98)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP98/03791

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP, 01-217950, A (Toshiba Corp.), 31 August, 1989 (31. 08. 89), Fig. 1 ; full text (Family: none)	7-9
Y	JP, 59-211339, A (NEC Corp.), 30 November, 1984 (30. 11. 84), Figs. 1, 2 ; full text (Family: none)	10-14
Y	JP, 07-030133, A (International Business Machines Corp.), 31 January, 1995 (31. 01. 95), Figs. 1 to 4 ; Par. Nos. [0012] to [0014], [0021] & US, 5005939, A & EP, 448989, A1	10-14
Y	JP, 05-021819, A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 29 January, 1993 (29. 01. 93), Fig. 1 ; Par. Nos. [0014] to [0018] (Family: none)	10, 12-14
Y	JP, 04-098880, A (NEC Corp.), 31 March, 1992 (31. 03. 92), Figs. 1, 2 ; full text (Family: none)	10

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. H01L 31/02

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. H01L 31/02, 31/12

## 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1940-1996
日本国公開実用新案公報	1971-1996
日本国登録実用新案公報	1994-1998
日本国実用新案登録公報	1996-1998

## 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	J P, 02-094573, A (日本電信電話株式会社) 5. 4月. 1990 (05. 04. 90) 図1, 5、第3頁右下欄下から3行—第4頁左上欄第6行 (ファミリーなし)	1-6, 8, 15, 16 7, 9-14
X Y	J P, 05-183185, A (富士通株式会社) 23. 7月. 1993 (23. 07. 93) 図1, 18段落6-8, 31-35 (ファミリーなし)	1-6, 10-11 7-9, 12-14
Y	J P, 09-152527, A (株式会社日立製作所) 10. 6月. 1997 (10. 06. 97) 図2、段落42 (ファミリーなし)	7-14

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの  
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

## の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
 「&」同一パテントファミリー文献

## 国際調査を完了した日

19. 11. 98

## 国際調査報告の発送日

01.12.98

## 国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)  
 郵便番号 100-8915  
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

## 特許庁審査官 (権限のある職員)

小原 博生

2K 8102

電話番号 03-3581-1101 内線 3255

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 09-191131, A (株式会社日立製作所) 22. 7月. 1997 (22. 07. 97) 図1、段落2-3, 6-7 (ファミリーなし)	7-14
Y	JP, 01-217950, A (株式会社東芝) 31. 8月. 1989 (31. 08. 89) 図1、全文 (ファミリーなし)	7-9
Y	JP, 59-211339, A (日本電気株式会社) 30. 11月. 1984 (30. 11. 84) 図1, 2、全文 (ファミリーなし)	10-14
Y	JP, 07-030133, A (インターナショナル・ビジネス・マシンズ・コーポレーション) 31. 1月. 1995 (31. 01. 95) 図1-4、段落12-14, 21 & US, 5005939, A & EP, 448989, A1	10-14
Y	JP, 05-021819, A (住友電気工業株式会社) 29. 1月. 1993 (29. 01. 93) 図1、段落14-18 (ファミリーなし)	10, 12-14
Y	JP, 04-098880, A (日本電気株式会社) 31. 3月. 1992 (31. 03. 92) 図1, 2、全文 (ファミリーなし)	10